

CMPD1001
 CMPD1001A
 CMPD1001S

**SURFACE MOUNT
 HIGH CURRENT
 SILICON SWITCHING DIODE**



www.centrasemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMPD1001 series types are silicon switching diodes manufactured by the epitaxial planar process, designed for applications requiring high current capability.



SOT-23 CASE

The following configurations are available:

CMPD1001 SINGLE
 CMPD1001A DUAL, COMMON ANODE
 CMPD1001S DUAL, IN SERIES

MARKING CODE: L20
MARKING CODE: L22
MARKING CODE: L21

MAXIMUM RATINGS: ($T_A=25^\circ\text{C}$)

Continuous Reverse Voltage
 Continuous Forward Current
 Peak Repetitive Forward Current
 Peak Repetitive Reverse Current
 Peak Forward Surge Current, $t_p=1.0\mu\text{s}$
 Peak Forward Surge Current, $t_p=1.0\text{s}$
 Power Dissipation
 Operating and Storage Junction Temperature
 Thermal Resistance

SYMBOL

V_R 90
 I_F 250
 I_{FRM} 600
 I_{RRM} 600
 I_{FSM} 6.0
 I_{FSM} 1.0
 P_D 350
 T_J, T_{stg} -65 to +150
 θ_{JA} 357

UNITS

V
 mA
 mA
 mA
 A
 A
 mW
 $^\circ\text{C}$
 $^\circ\text{C}/\text{W}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS PER DIODE: ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

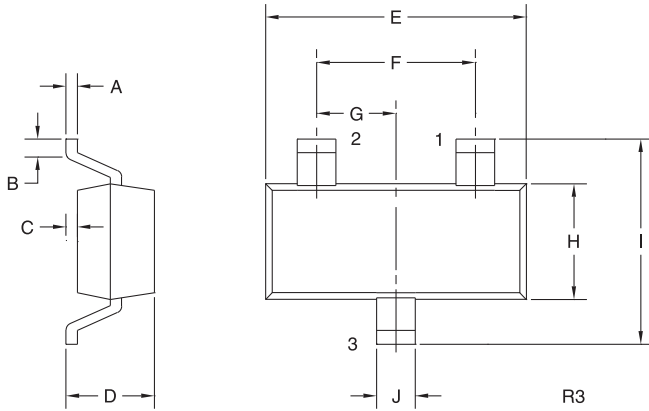
SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	MAX	UNITS
I_R	$V_R=90\text{V}$		100	nA
I_R	$V_R=90\text{V}, T_A=150^\circ\text{C}$		100	μA
BV_R	$I_R=100\mu\text{A}$	90		V
V_F	$I_F=10\text{mA}$		0.75	V
V_F	$I_F=50\text{mA}$		0.84	V
V_F	$I_F=100\text{mA}$		0.90	V
V_F	$I_F=200\text{mA}$		1.00	V
V_F	$I_F=400\text{mA}$		1.25	V
C_T	$V_R=0, f=1.0\text{MHz}$		35	pF
t_{rr}	$I_R=I_F=30\text{mA}, \text{Rec. to } 3.0\text{mA}, R_L=100\Omega$		50	ns

CMPD1001
 CMPD1001A
 CMPD1001S

**SURFACE MOUNT
 HIGH CURRENT
 SILICON SWITCHING DIODE**



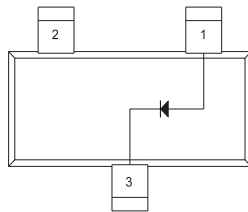
SOT-23 CASE - MECHANICAL OUTLINE



SYMBOL	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.003	0.007	0.08	0.18
B	0.006	-	0.15	-
C	-	0.005	-	0.13
D	0.035	0.043	0.89	1.09
E	0.110	0.120	2.80	3.05
F	0.075		1.90	
G	0.037		0.95	
H	0.047	0.055	1.19	1.40
I	0.083	0.098	2.10	2.49
J	0.014	0.020	0.35	0.50

SOT-23 (REV: R3)

PIN CONFIGURATIONS

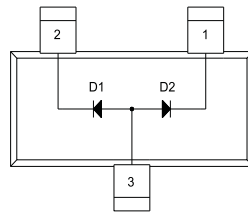


CMPD1001

LEAD CODE:

- 1) Anode
- 2) No Connection
- 3) Cathode

MARKING CODE: L20

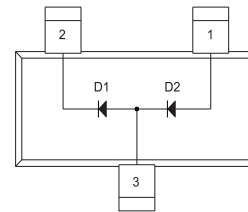


CMPD1001A

LEAD CODE:

- 1) Cathode D2
- 2) Cathode D1
- 3) Anode D1, Anode D2

MARKING CODE: L22



CMPD1001S

LEAD CODE:

- 1) Anode D2
- 2) Cathode D1
- 3) Anode D1, Cathode D2

MARKING CODE: L21

R6 (25-January 2010)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9